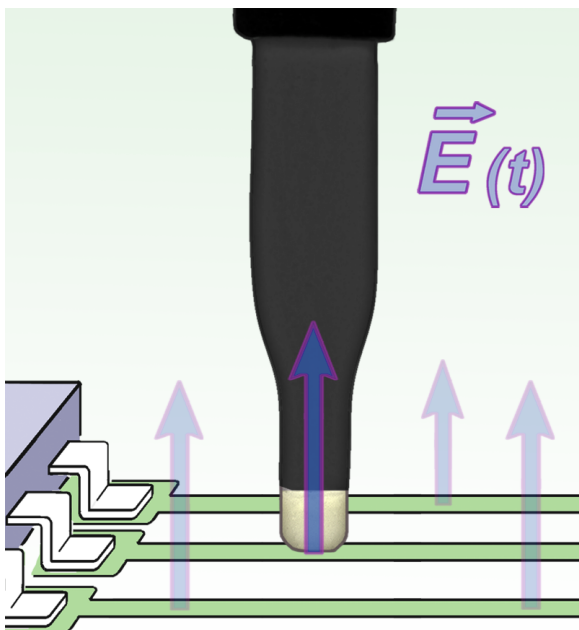


RFS-E 10

Scannersonde 30 MHz bis 3 GHz



Kurzbeschreibung

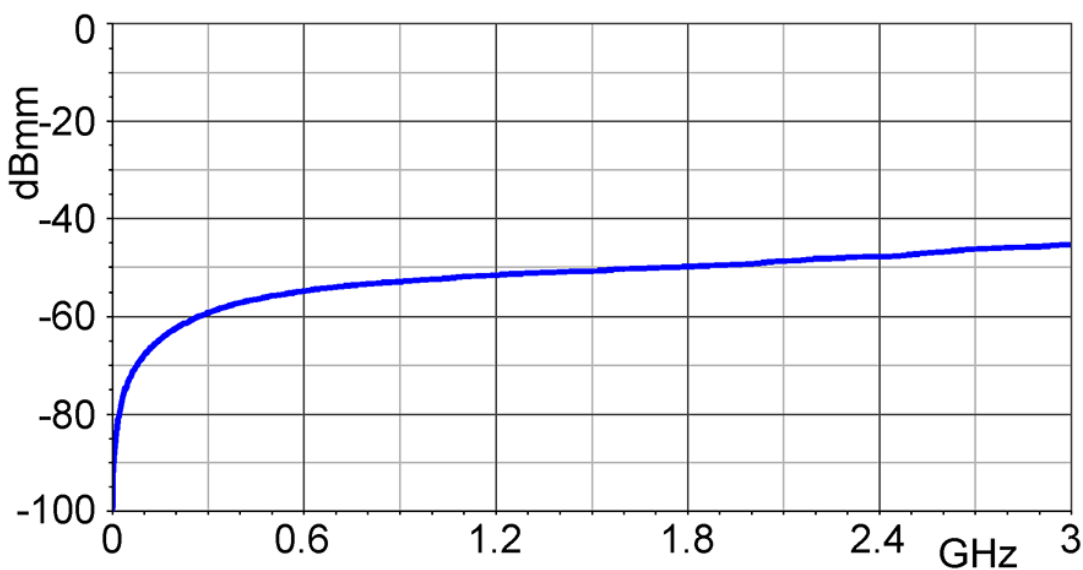
Die Elektrode in der Unterseite des Sondenkopfes der E-Feld Scannersonde RFS-E 10 ist ca. 0,2 mm breit. Damit können kleinste E-Feldquellen lokalisiert werden, z.B. 0,1 mm breite Leiterzüge, einzelne IC-Pins an hochpoligen ICs.

Die RFS-E 10 ist eine passive E-Feld Scannersonde. Typischerweise wird der Sondenkopf direkt auf das Messobjekt aufgesetzt (hohe elektrische Feldstärke). Die RFS-E 10 hat eine Mantelstromdämpfung und die Oberseite des Sondenkopfes ist elektrisch geschirmt. Die E-Feldscannersonde wird an einen Spektrumanalysator oder ein Oszilloskop mit 50 Ω Eingang angeschlossen. Die E-Feldsonde besitzt intern keinen 50 Ω Abschlusswiderstand.

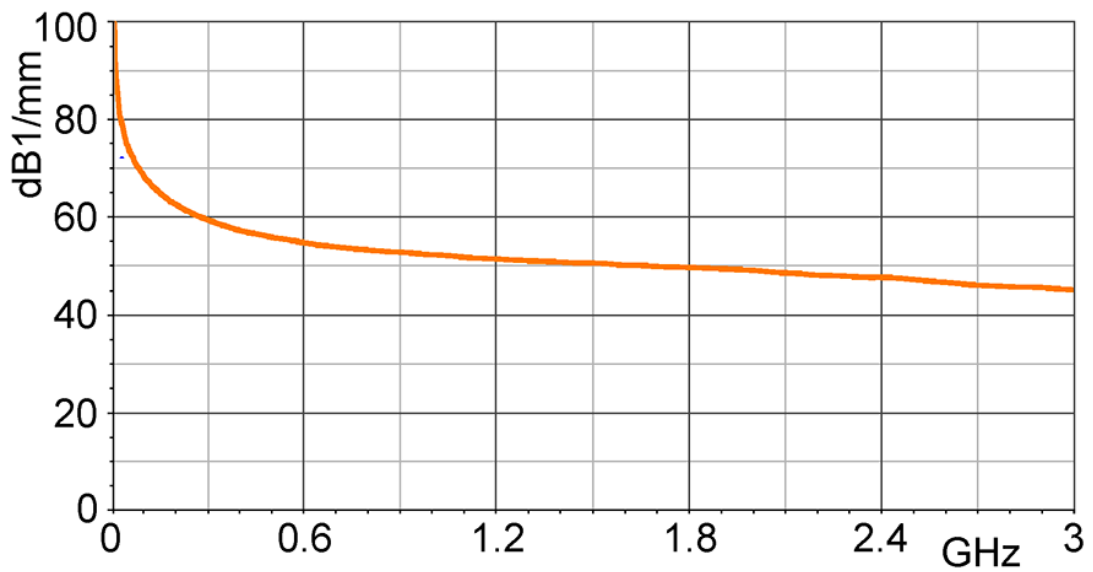
Technische Parameter

Frequenzbereich	30 MHz ... 3 GHz
Auflösung	≈ 0.2 mm
Maße Sondenkopf:	$\approx (0.5 \times 2)$ mm
Anschluss - Ausgang	SMA, male, jack

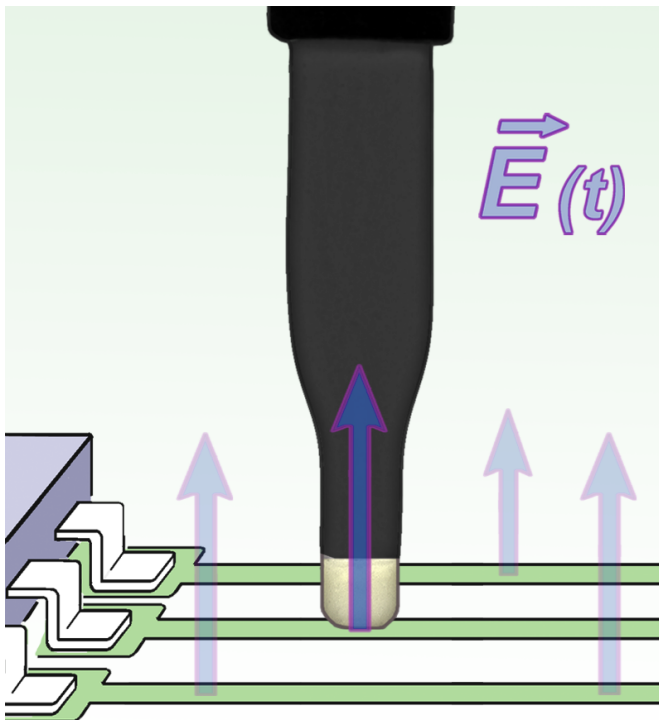
Frequenzgang [dB μ V] / [dB μ A/m]



Korrekturkurve E-Feld [dB μ V/mm] / [dB μ V]



Messprinzip



RFS-E 10

Scannersonde 30 MHz bis 3 GHz

LANGER
EMV-Technik

